

2SB673, 2SB674 2SB675

シリコンPNP三重拡散形(ダーリントン接続)

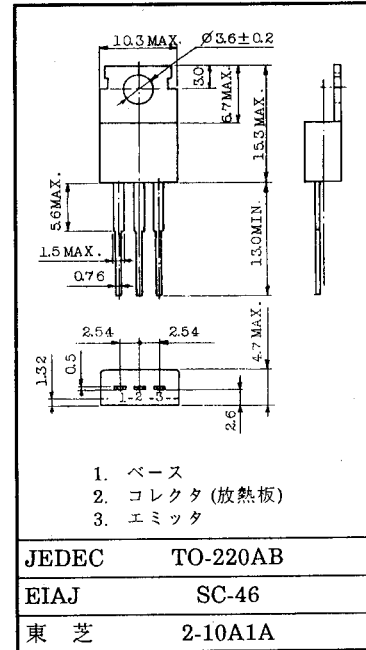
- 大電力スイッチング用
- ハンマードライブ, パルスモータードライブ用

- 直流電流増幅率が高い。
: $h_{FE} = 2000$ (最小) ($V_{CE} = -3V$, $I_C = -3A$)
- 飽和電圧が低い。: $V_{CE(sat)} = -1.5V$ (最大), ($I_C = -3A$)
- 2SD633, 2SD634, 2SD635とコンプリメンタリになります。

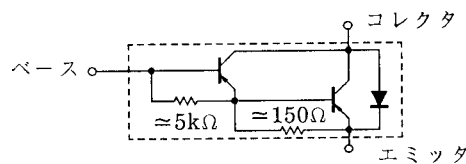
最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース 間電圧	2SB673	-100	V
	2SB674	-80	
	2SB675	-60	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SB673	-100	V
	2SB674	-80	
	2SB675	-60	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-7	A
ベース電流	I_B	-0.7	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	40	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

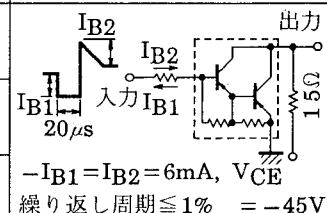
通信工業用
単位: mm



等価回路



電気的特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタ シャ断電流	2SB673	ICBO	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	—	—	-100	μA
	2SB674		$V_{CB} = -80V, I_E = 0$	—	—	-100	
	2SB675		$V_{CB} = -60V, I_E = 0$	—	—	-100	
エミッタシャ断電流		IEBO	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-4.0	mA
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SB673	V(BR)CEO	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-100	—	—	V
	2SB674			-80	—	—	
	2SB675			-60	—	—	
直流電流増幅率	hFE (1)		$V_{CE} = -3V, I_C = -3A$	2000	—	15000	
	hFE (2)		$V_{CE} = -3V, I_C = -7A$	1000	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	VCE (sat) (1)		$I_C = -3A, I_B = -6mA$	—	-0.95	-1.5	V
	VCE (sat) (2)		$I_C = -7A, I_B = -14mA$	—	-1.3	-2.0	
ベース・エミッタ間飽和電圧		VBE (sat)	$I_C = -3A, I_B = -6mA$	—	-1.55	-2.5	V
スイッチング 時間	ターンオン時間	t _{on}		—	0.8	—	μs
	蓄積時間	t _{stg}		—	2.0	—	
	下降時間	t _f		$-I_{B1} = I_{B2} = 6mA, V_{CE}$ 繰り返し周期 ≤ 1% = -45V	—	2.5	